PATENT-ABSTRACTS-OF-JAPAN

(T1)Publication number:

01=284583

(43)Date of publication of application: 15.11.1989

(51)Int.Cl.

C09K 11/08

C01G 9/08 H05B 33/14

(21)Application number: 63-113499

.....

(71)Applicant: MITSUBISHI METAL CORP

(22)Date of filing:

12.05.1988

(72)Inventor: NISHIHARA AKIRA

SAKAI YOICHI

YOSHIZUMI MOTOHIKO

(54) EL PHOSPHOR BASED ON DISPERSED ZNS

(57) Abstract:

PURPOSE: To obtain the title phosphor used for an electroluminescent element consisting of a transparent conductive layer, a luminescent layer, and a back electrode, exhibiting excellent luminance and life, by covering a part of the surface of a ZnS phosphor particle with a metal oxide.

CONSTITUTION: ZnS is mixed with Cu, Mn, Al, Mg, etc., as activator and Cl, Br, I, etc., as coactivator. This mixture is baked in an atmosphere of H2S to give ZnS phosphor particles, which are treated with an alkoxide of Ti, Al, Si or Zr and hydrolyzed to cover a part of the surface thereof with a metal oxide, such as TiO2, Al2O3, SiO2 or ZrO2, in such an amount that the intensity of the Zn element of the ZnS phosphor, determined by X-ray photoelectron spectroscopy, is 30-90% of that of the Zn element of an uncovered ZnS phosphor.

LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

⑩日本国特許庁(JP)

① 特許出題公開

平1-284583

@Int.Cl.4

識別記号

庁内整理番号

❸公開 平成1年(1989)11月15日

C 09 K 11/08 C 01 G 9/08 H 05 B 33/14

G-7215-4H

7202-4G 7254-3K審査請求 未請求 請求項の数 2 (全5頁)

6)発明の名称

ZnS分散型EL蛍光体

頭 昭63-113499 ②特

顧 昭63(1988)5月12日 22出

個発 明 者 原 西

埼玉県大宮市北袋町1-297 三菱金属株式会社中央研究 明

所内

明 者 坂 井 @発

埼玉県大宮市北袋町1-297 三菱金属株式会社中央研究

所内

@発 明者 住 素 彦

洋

埼玉県大官市北袋町1-297 三菱金属株式会社中央研究

所内

三菱金属株式会社 勿出 頭 人

東京都千代田区大手町1丁目5番2号

四代 理 人 弁理士 松井 政広

外1名

咡 錋

1. 毎明の名称

ZnS分數型EL量光体

2. 特許請求の範囲

- 1) ZnS粒子設面を金属酸化物がX線光電子分 光分析(XPS)により測定する場合にZnS貴光体のZn 元素の強度が未被覆のZnS量光体のZn元素に対 して30%以上90%以下の範囲の量で被覆している ことを特徴とするZnS分散型EL蛍光体粒子。
- 2) 上記金属磁化物は TiOz、AlzOy、SiOz 主たは ZrOzであり、金属アルコキシドを加水分解するこ とにより得られることを特徴とする請求項1に記 裁のInS分散型EL蛍光体。

3. 発明の詳細な説明

(技術分野)

本発明は、透明導電層、発光層、背面電極から なるな母発光素子において、発光層に含有される 2nS 蛍光体を金属酸化物で表面処理することによ り、蛍光体の輝度、彩命を向上した ZaS分散型EL **蛍光体の改良に関するものである。**

(従来の技術と問題点)

從来、ZnS分散EL型蛍光体はZnSにCu、Al等を活 性化剤として添加して H.S等の雰囲気で焼成する ことにより得られていたが、この方法で得られた 蛍光体を用いて作数した発光素子は輝度が低く舞 命が短かいという欠点があった。これは分散型EL 電場発光素子は以下に記すようにSbをドープした SnO. や SnをドープしたIn.O. 等からなる透明準電 層を抜者したガラス基板と、その上にZn5蛍光体、 BaTiO。等の誘電体、エポキシ樹脂、シリコーン樹 脂等のパインダーからなる発光層と、さらにその 上にAI等の金属からなる背面電極により構成され ており、発光層中の ZnS蛍光体粒子が十分に接触

- 7 -

- 1 -

しておらず高電器を必要とし、また、ZnS 登光体在 子同志の周辺で超速電流を生じるためである。さ らにZnS は複型の水分で分解されやすく、Zn(OH)。 またはZnOを生じやすく、それによっても印度が 低下するので加熱処理、酸エッチング処理等が行 なわれている。 また ZnS表面を金属酸化物で均 一に被覆して劣化を防止する方法もとられている が、逆に導電性低下をまねき十分な高印度、長寿 令を得ることができない。

Zns の耐湿性を向上させるために金属アルコキシドの加水分解またはゾルゲル法によって Zns粒子の表面に金属酸化物の被覆を形成したものは知られている。然し従来既知のものは粒子の表面が全面的に金属酸化物が枝覆されているので、電場発光素子としては十分に慢能を発揮しえない。

(問題解決にかかる知見)

本発明者らは ZnS蛍光体の表面を均一に金属酸 化物で被覆するのではなく、 ZnSの水に対する活 性を低めれば蛍光体の機能を低下させないで、耐 混性が向上するのではないかとの予測に基づき、

- 3 -

性が阻害されないため高輝度・長寿命の ZnS蛍光 体が得られると説明できる。

本発明における ZnS蛍光体粒子表面の金属酸化 物の付着量はX線光電子分光分析(XPS) により規 定され、金属酸化物で被覆されていない ZnS蛍光 体の2n元素の強度を100%とし、金属酸化物で完 全に披覆されたときの強度をO%とすると、Zn元 素の強度が30%以上90%以下の範囲である。2n元 素の強度が30%未満では ZnS蛍光体粒子表面に金 **風酸化物が多量に存在するため薄質性が悪くなり** 輝度が低下する。またZn元素の強度が90%を越え る範囲においては ZnSの表面活性が抑制されず從 来品との有意差が認められない。また当然のこと ながら InS蛍光体の粒子表面の一部が金属酸化物 で被覆されていることが前提条件であり、金属酸 化物の添加量は ZnS蛍光体に対して好ましくは10 重量を以下の範囲であり、深さ方向の分析を行っ で金属酸化物と ZnS蛍光体の混合物でないことを 確認しなければからない。

粉末の表面被覆率を翻べることは難しく、本発

説意検討した結果、金属アルコキシドの ZnS粒子 袋面での加水分解反応を制御することにより、予 想以上に高輝度、長寿命の ZnS蛍光体を得る方法 を見出し本発明に至った。

(発明の構成)

本発明は、ZnS粒子表面を金属酸化物がX線光電子分光分析(XPS)により選定する場合にZnS量光体のZn元素の強度が未被覆のZnS量光体の Zn元素に対して30%以上90%以下の範囲の量で被覆していることを特徴とする ZnS分散型EL量光体粒子を提供する。

好ましい金属酸化物は TiO₂、Al₂O₃、SiO₃、 ZrO₂等であり、対応するアルコキシドから生成される。

金属アルコキシドが ZnS粒子表面の銀水基と反応し、粒子の表面でZn-0-K (金属) を形成することにより ZnS粒子全体の表面活性が低下して、水との反応性が弱まるとともに表面処理により樹脂への分数性が高まり、さらに ZnS粒子表面の金属降化物の技質量を制御することにより ZnSの導電

-4-

明者らは X 線光電子分光分析法により行なった。これは表面分析手法の一つであり、これによれば 粉末の表面被瑕はある面積に平均化して表わされるので、粉末の被瑕の程度を判定することができる。 設面被殴されたものと単なる混合物は見掛けの設面2n 強度が同じでも、 4r エッテングにより深さ方向の分析を行うことによって明確に区別でき

本発明における金属酸化物は、好ましくはT10.x、A1.x0、S10.x、Zr0.x 等であり、これらの金属アルコキシドを加水分解することにより得られる。またアルコキシドの短類は上記金属のメトキシド、エトキシド、イソプロポキシド、プロポキシド、ブトライソプロポキシド、アルミニウムトリイソプロポキシド、シリコンテトラメトキシド(メテルシリケート)、シルコニウムテトラブトキシドの超点のサルシリケート)、ジルコニウムテトラブトの超合物(部分加水分解物)も使用することができる。

また金属アルコキシドの加水分解を調整したり、 例えば加水分解の早いジルコニウムテトラブトキ シドをシリコンテトラエトキシドと混合する等、 その他酸化物の軽気的特性を付加するためチタニ ウムテトライソプロポキシドを混合する等、上記 の金属アルコキシドを混合して用いても良い。

- 7 -

ここで得られた蛍光体 ZnS 10重量部を特級エチルアルコール(99.5%) 100重量部に分散させた後、チタニウムテトライソプロポキシドを 0.1重量部加えて 2時間十分に混合競拌した。その後進過して溶媒を除去した後 0.2kアンモニア水100重量部に ZnS蛍光体を 1 時間分散させ、再び滤別して 200 での真空乾燥で 3 時間乾燥した。ここで得られた T10x 処理 ZnS蛍光体の表面 Zn 元素強度を X 線光電子分光分析(XPS) により測定し、処理前の ZnS蛍光体の表面 Zn元素強度と比較したところ、処理前に対して 90%であった。また、上記比率で ZnS蛍光体と Ti0x を混合したものの Zn 強度は 98%であった。

またArエッチングにより深さ方向の分析を行なったところ、1分のエッチングでZn強度が92%、3分のエッチングで96%、5分のエッチングで98%となり、ZnS表面がTiOzで被覆されていることが確認された。一方比較に用いた混合品は、同様にArエッチングにより深さ方向の分析を行なっても2n強度に変化がなかった。

なお本発明に用いられる ZnS 蛍光体は分散型に 蛍光体であり、通常 ZnSにCu、Mn、A1、Ng等を活 性化剤として、C1、Br 或いは I を補助活性化剤と して加えた後 800~1,000℃でHg S 雰囲気中で焼成 して得られるものであり、蛍光を発するものであ れば何れでも良い。

(発明の効果)

以上述べたように本発明による金属酸化物処理 ZnS 蛍光体は透明率電層、発光層、背面電極から なる電優発光素子において、輝度・寿命に優れた 特性を発揮する。

(発明の具体的闘示)

以下、本発明を実施例によって具体的に説明す る。

实施例1

高純度のZnS 100重量部に酢酸第二類0.25重量 部、破酸アルミニウム0.23重量部を加え、さらに フラックスとして塩化バリウム0.13重量部添加し て十分に混合した後H₂S雰囲気中980℃で10時間焼 成を行なって、平均粒径20μmのZnS蛍光体を将た。

-8-

次いで IIO2 処理ZnS 蛍光体をシリコーングリース (信絃化学算、HIVAC-G)(バインダー) と容積比1:1で混合して発光層 (厚さ100 дm) とした電 培発光素子を作製し、10kHzで500 V 印加して輝度を測定した。その結果650ntであった。

また初期輝度100ntで10kHz印加して湿度40%、 温度20℃の条件で輝度20ntになるまでの時間を源 定した。その結果58時間であった。

以下の実施例は表面処理方法だけについて述べ、 金属酸化物処理 ZnS量光体の未処理に対する表面 Zn元素強度比と電場発光素子の輝度・寿命は各々 実施例1と同様に測定しその結果を第1表に記し てある。

实施例2

実施例1で生成したZnS蛍光体(以下未処理ZnS 蛍光体と称する)10重量部をあらかじめ 300℃で 1時間加熱処理した後、特級エチルアルコール 100 重量部に分散させた後、チタニウムテトライ ソプロポキシド2重量部を加えて10時間十分に混 合後、1Nアンモニア水を滴下してpH 8としさらに 5時間挽押した。その後違別して24時間風乾した 後、200℃の真空乾燥器で3時間乾燥してTiO₂処理 ZnS蛍光体を得た。

卖施例3…

未処理ZnS 蛍光体 10重量部をベンゼン20重量部に分散させた後、アルミニウムトリイソプロポキシド 0.1重量部添加して5時間混合後特級エチルアルコール80重量部加えて2時間提择した。その後建別して24時間風乾した後、100℃ で24時間乾燥してA1x0,処理ZnS蛍光体を得た。

实施例4

未処理ZnS蛍光体 10重量部を特級エチルアルコール10重量部に分散させた後、ジルコニウムテトラブトキシド3重量部添加して、10,000rpm の高速で5分間提辞した。その後達別して24時間風乾後500℃で1時間焼成してZr0。処理ZnS蛍光体を得た。

实施例5

未処理2nS蛍光体 10重量部をエチルアルコール 100 重量部に分散させた後、シリコンテトラエト

- 11 -

同乾燥して得られた ŤiO₂処理ZnS蛍光体を実施例 1と同様に試験を行ない、その結果を第1表に記 した。

比较例3

未処理ZnS蛍光体 10選量部を特級エチルアルコール 100重量部に分散させた後、ジルコニウムテトラブトキシドを 1.5重量部添加して24時間提幹後、1% HC1 0.04度量部、水0.15重量部を加えて、さらに24時間提辞した。次いでINアンモニア水を滴下してpH 8とし、24時間提辞後、スプレードライヤーにて 250℃で噴霧乾燥して得られたZrO±処理蛍光体を実施例1と同方法、同条件で試験を行ない、その結果を第1設に記した。

比較例4

キシドの.2重亜部添加して2時間提幹技TK HC1 0.01重量部添加して60℃に加選して1時間提拌した。その後スプレードライヤーにて 250℃で噴霧 乾燥して510.処理2nS蛍光体を得た。

实施例6

未処理ZnS宏光体 10重金部を四塩化炭素10重量 部に分散させた後、シリコンテトラエトキシド1.8 重量部とチタニウムテトラインプロポキシド1.5 重量部添加して、30分間提拌後達別し24時間 四粒した。その後500℃で1時間焼成してSiO.・TiO.処理ZnS蛍光体を得た。

比較例1

未処理ZnS 蛍光体を実施例1と同じ方法で電場 発光素子を作図し、同じ条件で頑度と寿命を測定 した。その結果を第1表に記した。

比較例2

未処理2nS蛍光体 10重量部を特級エチルアルコール 100重量部に分散させた後、チタニウムテトライソプロポキシド0.05重量部部加して5分間提择し、遊ちに透別し、24時間風乾後 100℃で24時

- 12 -

1と同様に試験を行ない、その結果を第1表に記した。

上記窦施例および比較例において、意場発光素子の輝度寿命を調べたところ、本発明によって得られた金属酸化物処理ZnS蛍光体は、未処理のZnS蛍光体は、未処理のZnS蛍光体は、未処理のZnS蛍光体は、未処理のZnS蛍光体に比べて著しく輝度と海命が改良された。また本発明に係る製品は金属酸化物の付着量、比外の領に示したように本発明により規定された以外の領域では電場発光素子の輝度・寿命の次を発表した。2nS蛍光体の表面のZn元素強であるとでは、2nS蛍光体の表面のZn元素強である表面処理方法がZnS蛍光体の高輝度・表発命を得るのに低れた方法であることが確認された。

第 1 表

70 × 50			
	25速度比(%)	超 皮 (nt)	券 命(t)
実施例1	90	650	58
. 2	30 .	820	. 95.
3	80	700	72
4	60	930	115
5	30	1050	102
6	50	580	125
比較例1	100	500	35
2	95	500	35
3	10	300	28
4	75	420	38

注 Zn強度比= <u>処理ZnS蛍光体の表面Zn元素速度</u> × 100 未処理ZnS蛍光体の表面Zn元素速度

> 特許出顧人 三菱金属 株式会社 代理 人 弁理士 松井 政広(外1名)